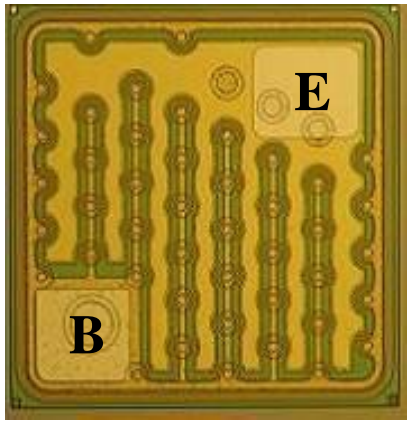


产品资料

几何参数

管芯尺寸 (MASK)	0.53 × 0.53 mm		
管芯厚度	210 ± 20 μm		
压焊区尺寸	基极	113 × 108 μm	
	发射极	130 × 108 μm	
正面金属层	Al		
背面金属层	Au		
圆片尺寸	Φ 125 mm		
每片有效管芯数	37,200		

极限值 (绝对最大额定值) (Ta=25°C) TO-92

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V_{CBO}	-50	V
集电极电流	I_C	-500	mA
集电极功耗	P_C	625	mW
结温	T_j	150	°C

电特性 (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -0.05mA, I_E = 0$	-50			V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -1mA, I_B = 0$	-45			V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E = -0.05mA, I_C = 0$	-6			V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -45V, I_E = 0$			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-0.1	μA
直流电流增益	HFE1	$V_{CE} = -1V, I_C = -100mA$	125		500	
	HFE2	$V_{CE} = -1V, I_C = -500mA$	45			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$			-0.65	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$			-1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -10mA, f = 30 MHz$	100			MHz



扬州晶新微电子有限公司